精选快讯　硬件快讯　2026年11月19日 22:40

美光称3DRAM最快2028年问世，CEO指散热为主要挑战

要点

- 美光在财报会议上透露，面向未来的3DRAM内存最快将于2028年问世。
- 根据美光此前公布的技术指标，3DRAM带宽预计可达4-10TB/s，延迟可控制在10nm以内。
- 尽管前景广阔，美光CEO明确表示散热是3DRAM面临的主要挑战。

美光在财报会议上透露，面向未来的3DRAM内存最快将于2028年问世。作为目前唯一明确拒绝从现有6F2架构直接转向4F2的内存厂商，美光计划通过键合工艺进行过渡，最终直接演进至3DRAM架构。

根据美光此前公布的技术指标，3DRAM带宽预计可达4-10TB/s，延迟可控制在10nm以内。在能效方面，其每比特功耗有望降至0.5pj/bit以下，整体性能提升多达5倍，功耗降低80%以上。美光CTO指出，将3DRAM直接堆叠在GPU及AI芯片上，能显著提升带宽并降低功耗。

尽管前景广阔，美光CEO明确表示散热是3DRAM面临的主要挑战。按照美光预测，3DRAM将在2028-2029年开始进入市场，并于2030-2031年大幅普及。其应用场景不仅限于高端AI芯片，还将覆盖手机、笔记本等边缘设备。

报道来源：快科技

来源网站：https://www.inews.today/